

RX63N サブクロック特性評価結果

評価条件

- ・発振子 VT-200-FL/4.4pF
- ・回路定数 Cg=5pF、Cd=5pF、Rd=0kΩ、Rf=NC
- ・MCU RX63N R5F563NEDDFP
- ・ドライブ能力 RCR3, RTCDV[2:0]=001b (低CL用ドライブ能力)

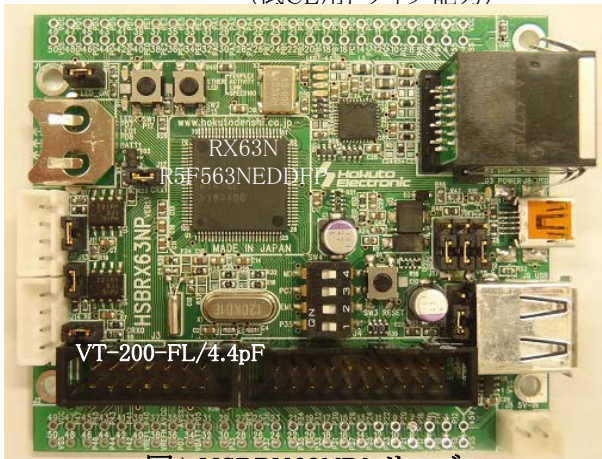


図1.HSBRX63NPシリーズ (株式会社北斗電子製)

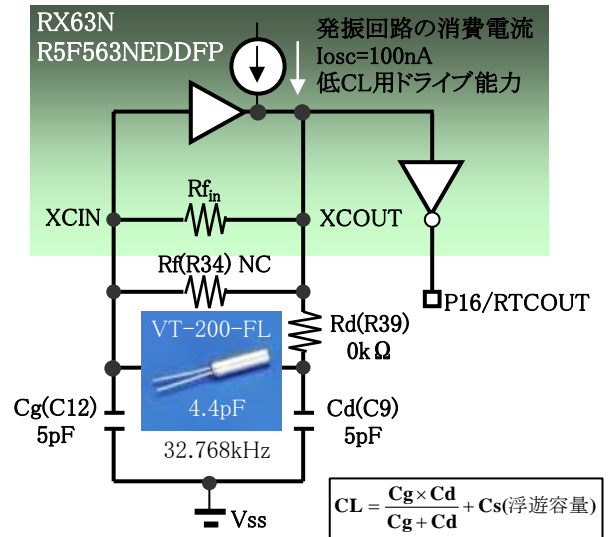


図2.評価回路図

表1.サブクロック特性結果(動作電圧=5.0V、25°C)

項目	結果	備考
	RCR3, RTCDV[2:0]=001b	
周波数オフセット: df / f	-1.09 × 10 ⁻⁶	VT-200-FL/4.4pF、Cg=5pF、Cd=5pF、Cs=1.9pF
周波数電圧特性 : df / Vdd	0.49 × 10 ⁻⁶	動作電圧=1.8V~5.5V
励振レベル : DL	0.01 μW	絶対最大励振レベル 1 μW
負性抵抗 : -RL	-386 kΩ	発振余裕度は5倍以上を推奨 発振余裕度=負性抵抗/等価直列抵抗(50kΩ)
発振余裕度 : M	7.7 倍	
発振開始電圧 : Vstrat	0.70 V	
発振停止電圧 : Vstop	0.67 V	
発振起動時間 : Ts	1.00 Sec.	電源投入後、出力レベルが90%に達する時間

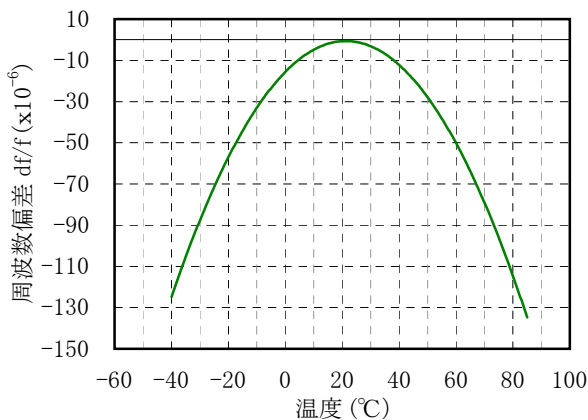


図3.周波数-温度特性

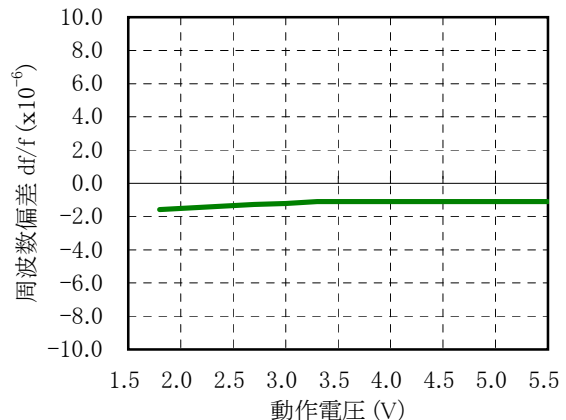


図4.周波数-動作電圧特性

お問い合わせ

セイコーインスツル株式会社

水晶営業部

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8

Tel:043-211-1207 Fax:043-211-8032

E-mail :component@sii.co.jp

URL :http://www.sii-crystal.com